Статьи, опубликованные в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и изданий:

1. Мокроусов Г.М., Зарубина О.Н. Формирование поверхностного и приповерхностного слоев на полупроводниках типа $A^{III}B^{V}$ // Известия Томского политехнического университета. – 2008. – Т. 313, № 3. – С. 25–30. – 0,71 / 0,35 п.л.
2. Мокроусов Г.М., Зарубина О.Н., Бекезина Т.П. Межфазные превращения в системе GaN-H_2O (pH) // Бутлеровские сообщения. – 2011. – Т. 24, № 2. – С. 58–62. – 0,40 / 0,28 п.л.
3. Зарубина О.Н., Мокроусов Г.М., Бекезина Т.П., Найден Е.П. Физико-химия процессов на границе многокомпонентное вещество-раствор. Состав и строение поверхности // Бутлеровские сообщения. – 2011. – Т. 24, № 3. – С. 61–69. – 0,73 / 0,24 п.л.
4. Zarubina O.N., Mokrousov G.M., Naiden E.P. The composition and structure of interphase boundaries of III–V semiconductors formed in a liquid medium // Russian Physics Journal. – 2012. – № 12. – P. 1375–1383. DOI: 10.1007/s11182-012-9757-x. Russian Original No. 12, December, 2011. – 0,58 / 0,35 п.л.
5. Зарубина О.Н., Мокроусов Г.М. Межфазные превращения в системе H_2O (pH) – арсенид галлия (индия). Формирование поверхностного фазового слоя на полупроводнике // Бутлеровские сообщения. – 2009. – Т. 17, № 6. – С. 33–40. – 0,58 / 0,30 п.л.

Статьи в других научных изданиях:

6. Зарубина О.Н., Мокроусов Г.М., Изаак Т.И. Формирование и определение мышьяка на поверхности арсенида галлия // Полифункциональные материалы и нанотехнологии : сборник статей : в 2 т. / под ред. Г.Е. Дунаевского, В.В. Козика, В.И. Сырямкина, М.А. Гавриленко. – Томск, 2008. – Т. 1. – С. 196–199. – 0,24 / 0,12 п.л.
7. Зарубина О.Н., Мокроусов Г.М. Методология прогнозирования состава и строения межфазных границ и поверхностных структур для многокомпонентных веществ // Полифункциональные материалы и нанотехнологии : сборник статей : в 2 т. / под ред. Г.Е. Дунаевского, В.В. Козика, В.И. Сырямкина, М.А. Гавриленко. – Томск, 2008. – Т. 2. – С. 46–48. – 0,18 / 0,09 п.л.
8. Мокроусов Г.М., Зарубина О.Н. Формирование поверхностных наноструктур путем селективного удаления одного из компонентов полупроводникового соединения // Химия твердого тела и современные микро- и нанотехнологии : материалы VIII международной научной конференции. – Ставрополь, 2008. – Т. 1. – С. 53–55. – 0,18 / 0,09 п.л.
9. Зарубина О.Н., Мокроусов Г.М. Комплексное применение методов твердофазной вольтамперометрии и КР-спектроскопии для контроля состава поверхности GaAs // Методы исследования состава и структуры функциональных материалов : материалы 1-й всероссийской научной конференции (Новосибирск, 11-16 октября 2009 г.). – Новосибирск, 2009. – С. 235. – 0,12 / 0,08 п.л.

10. Мокроусов Г.М., Зарубина О.Н. Диагностика состава и структуры поверхности многокомпонентных веществ на основе методологии ее формирования и измеряемой величины электродного потенциала // Методы исследования состава и структуры функциональных материалов : материалы 1-й всероссийской научной конференции (Новосибирск, 11-16 октября 2009 г.). – Новосибирск, 2009. – С. 240. – 0,18 / 0,09 п.л.

11. Зарубина О.Н., Мокроусов Г.М., Найден Е.П. Формирование поверхности InSb в процессе химического травления в жидких средах // Физика и химия высокоэнергетических систем : сборник материалов шестой всероссийской конференции молодых ученых (Томск, 14–17 апреля 2010 г.). – Томск, 2010. – С. 382–383. – 0,12 / 0,08 п.л.

12. Мокроусов Г.М., Зарубина О.Н. Методология формирования поверхности и создания поверхностных наноструктур на полупроводниках $A^{III}B^{V}$ в жидких средах // Труды международной научно-технической конференции и молодежной школы-семинара (Дивноморское, 19–24 сентября 2010 г.) : в 2 ч. – Таганрог, 2010. – Ч. 1. – С. 49–51. – 0,18 / 0,09 п.л.

13. Мокроусов Г.М., Зарубина О.Н. Селективное травление InSb и InAs как метод подготовки поверхности к формированию гетероструктур // Труды международной научно-технической конференции и молодежной школы-семинара (Дивноморское, 19–24 сентября 2010 г.) : в 2 ч. – Таганрог, 2010. – Ч. 1. – С. 216–217. – 0,12 / 0,08 п.л.

14. Tsai W., Chu C.H., Weng S.-C., Zeng Y.-Z., Chen H.-Y., Yan Y.-H., Zarubina O.N., Mokrousov G.M., Chang S.-L. Mapping the Strain Field of Chemically Treated Surface of Semiconductor Crystals Using X-Ray Bragg-Surface Diffraction // 10th Conference of the Asian Crystallographic Association. − Busan, 2010. – 0,12 / 0,04 п.л.

15. Mokrousov G., Zarubina O. Purposeful formation of interface boundaries (surface, structure) on multicomponent semiconductors // Taiwan-Siberian Innovation Forum, 10.24-10.29. − Taipei, 2011. − P. 172. – 0,06 / 0,04 п.л.

16. Зарубина О.Н., Куйдина Г.Ю. Формирование межфазных границ многокомпонентных полупроводников в жидких средах // Полифункциональные химические материалы и технологии : материалы общероссийской с международным участием научной конференции, посвященной 80-летию химического факультета Томского государственного университета. − Томск, 2012. – С. 38-39. – 0,12 / 0,10 п.л.

17. Зарубина О.Н., Мокроусов Г.М. Химическое формирование защитного покрытия на поверхности InAs // Полифункциональные химические материалы и технологии: материалы общероссийской с международным участием научной конференции, посвященной 80-летию химического факультета Томского государственного университета. − Томск, 2012. – С. 40-41. – 0,12 / 0,09 п.л.

18. Мокроусов Г.М., Зарубина О.Н. Электрохимическое формирование межфазных границ полупроводников $A^{III}B^{V}$ // Химия и химическая технология: достижения и перспективы: материалы Всероссийской конференции. − Кемерово, 2012. – С. 24-26. – 0,18 / 0,12 п.л.